# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

# **EUROPEAN PATENT OFFICE**

# Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

04129745

**PUBLICATION DATE** 

30-04-92

**APPLICATION DATE** 

21-09-90

APPLICATION NUMBER

02252254

APPLICANT: SEIKO EPSON CORP:

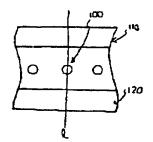
INVENTOR: ONO YOSHIHIRO;

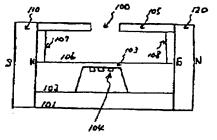
INT.CL.

B41J 2/045

TITLE

**INK JET HEAD** 



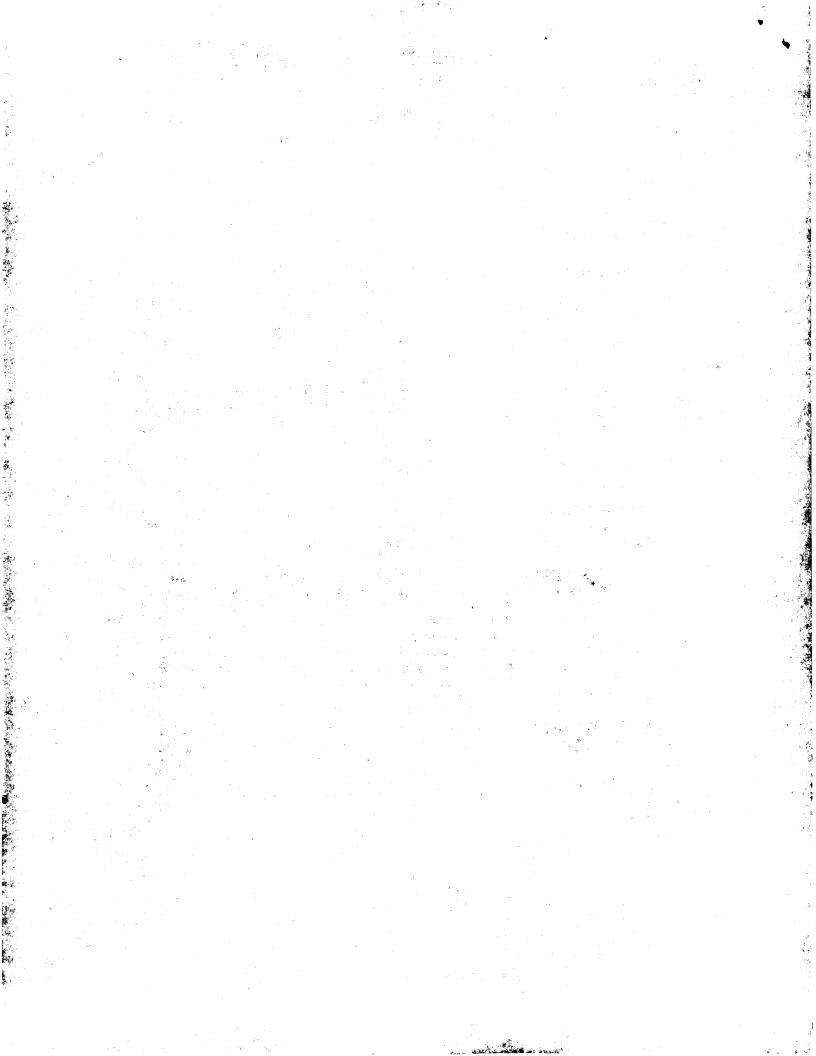


### ABSTRACT :

PURPOSE: To improve the life and printing quality (high density dot) by a method wherein a substrate which comes into contact with an ink has a diaphragm structure, and this diaphragm is displaced by magnetic force from the outside.

CONSTITUTION: Line of magnetic force which is generated by magnets 110, 120 arranged at both sides of an ink jet head goes across the inside of the ink jet head. At this time, electric current is charged in the wiring on a diaphragm 103, conforming to Fleming's rule, force is applied to the wiring 104, i.e., to the upper part or lower part of the diaphragm, in proportion to the strength of the line of magnetic force and the current value. The direction in which the force is applied is determined by the direction of the line of magnetic force and electric current, and by this force, the diaphragm is displaced, and pressure is added to the ink is surrounded by substrates 102 and 105, and the ink drop flies out from an ink discharge port 100.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio



19 日 本 国 特 許 庁 (JP)

⑩ 特許出願公開

# <sup>®</sup> 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-129745

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内築理番号

每公開 平成 4年(1992) 4月30日

B 41 J 2/045

9012-2C B 41 J 3/04

103 D

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全4頁)

❷発明の名称 4

インクジェットヘッド

②特 願 平2-252254

②出 願 平2(1990)9月21日

@発明者 大野

好 弘

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会社内

⑦出 願 人 セイコーエプソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

四代 理 人 弁理士 鈴木 喜三郎

外1名

明 細 {

1. 発明の名称

インクジェットヘッド

# 2. 特許加求の范囲

(1) インク106と接する55板102がダイヤフラム和適をもち、このダイヤフラムが外部からの力によって変位することによって、55板102と105によって囲まれている空間内に圧力変化を生じさせ、大100からインク106を吐出させることを特位とするインクジェットヘッド。

(2) 額求項1配徴のインクジェットヘッドにおいて、ダイヤフラム103の変位を、インクジェットヘッドの左右の磁石からの磁力性とダイヤフラム上に形成された配約104の中を流れる包液によって作られる力によって起されることを特徴とするインクジェットヘッド。

(3)和求項1記録のインクジェットヘッドにおいて、ダイヤフラムにかかる力が、最初ダイヤフ

ラムを基板 1 0 1 の方に引く力となるように配約 1 0 4 の中を気流が流れ、次いでその逆 位性に 収 流が流れることにより ダイヤフラムの変位を 基板 1 0 5 の方向へ起すことを特徴とするインクジェットヘッド。

### 3. 発明の詳細な説明

【意口上の利用分野】

本発明は、インク和を飛翔させ記級越体上に延 級を形成するインクジェット記載のヘッドの构造 に関するものである。

# 「従来の技術」

インクジェットヘッドの和追は和々担選されているが、現在受用化されているのはインク内での 発無体の無発生によりインクの原発によるパブル 発生で圧力を生じさせる方式(第3図)とピエゾ 等の圧回気子を51板に取り付け、圧回気子の変形 を利用し55板を変位させることによりインクタン ク内の圧力を変化させる方式(第4図)がある。

以3図は発魚体方式によるインクジェットへッ

第4図は圧電素子方式のインクジェットへッドの断面図であるが、基板401にピエゾ等の圧電 素子を貼り付け、基板403と組み合わせるこことによりなるものである。圧電素子は一般にア子形成にようなセラミックを焼成により形成し素子が成に切り出すことにより得られるこのインクシェットへッドの駆動は、圧電素子402に電圧をかけることにより、圧電素子をたわませると供に、基

いという欠点があった。

又、一方の圧電素子タイプは、発熱方式とは逆に上記のようなダメージがないためヘッド寿命は長いものの、圧電素子をセラミックプロックから切り出し、貼り付けるという工程からわかるように駆動素子の高密度化が困難な構造となっている。

そこで本発明はこのような問題点を解決するもので、その目的は、駆動素子の高密度化が可能でかつ寿命の長いインクジェットヘッドを提供するところにある。

# [課題を解決するための手段]

本発明のインクジェットヘッドはインク106と接する基板102がダイヤフラム構造をもち、このダイヤフラムが外部からの力によって変位することにより、基板102、105によって囲まれている空間内に圧力変化を生じさせ、大100からインク106を吐出させることを特徴としている。

〔作 用〕

板 4 0 1 を同時にその力でたわませることにより、インクジェットヘッド内の圧力を変化させ、インク 4 0 4 を 4 0 5 の穴から吐出させるタイプのものである。

# {発明が解決しようとする課題}

前述の発熱素子タイプ及び圧電素子タイプはそれぞれ長短を持っている。

発熱タイプは、ICプロセスのようないわゆる 薄膜プロセスによって駆動体となる発熱素子を形成できるため、駆動業子の高密度化は容易であ り、このため小型のインクジェットヘッドの中に 多くのインク吐出口を形成できるため、シリアル ヘッドの場合は高速でヘッドの移動が可能でかっ 高密度印字の可能なヘッドを形成することができ る、又、ラインヘッドの場合は高密度印字が可能 となる。

しかし、発熱方式によるため、加熱・急冷の繰り返しにより業子がダメージを受けること、及びインク中のバルブ消滅時の衝撃により発熱体がダメージを受けることによりヘッド自体の寿命が短

本発明の上記の構成を第1図-a)と第1図-b)に示す。第1図a)は本発明のインクジェットヘッドをインクの吐出口100例の正面から見た図であり第1図b)は本発明のインクジェットヘッドをライン&で切った断面図を示している。

本発明の上記の構成であれば、インクジェット ヘッドの両側に配された磁石により作られる田力 線がインクジェットヘッド内を横切る。この時、 ダイヤフラム上の配線内に電流を流すと、フレミ ングの左手の法制に従い、磁力線の強さ、電流値 に比例して、配線104に、即ちダイヤフラムの 上方あるいは下方へ力が加わることになる。

力の加わる方向は、磁力線及び電流の方向によって決まり、これによってダイヤフラムが変位し基板 1 0 2 と 1 0 5 によって囲まれたインクに圧力が加わり、インキ吐出口 1 0 0 からインク滴が飛び出す。

次に実施例を用いて詳細に説明する。

## [実施例1]

第1図(b)に本発明のインクジェットヘッド

の断面図を示すが、その製造プロセスは、

1)100単結品Si基板を研磨により100μm以とし基板102とした役、Si基板の片のから設さ1μmにポロンを拡放した。このポロン拡放した。このポロンなないのは次工程でのエッチングストップ同となる。2)5i五板102のポロン拡放門と逆側に110方向へ1辺を合せ、1辺240μmの正方形のスを持つレジストパターンを形成し、80℃、30%和反のKOH溶液に投稿し、Si基板は単結品であるため、KOHに対し結品方位によりエッチングスピードの足がある。即ち選択エッチング性があり、弱2図に示す形状にエッチングされた。

工程 1 ) で形成したポロン拡政 口は、 K O H に対してエッチングスピードが返く、 1 μ m 厚 のシリコン・ポロン 目を残すことができ、これを 引 1 図のダイヤフラム 日 1 0 3 とした。

3) 次に頃1図b) ダイヤフラム部103に所定のパターンの配組104を形成した。 配線:04 は蒸谷によりAe∇を2μmの厚さで形成した

役、配組104にフレミングの法則により力が吐出口100の方向へかかるように包流を流したところ、インク吐出口100からインク消を飛ばすことができた。

## [突 箱 例 2]

## [交 施 例 3]

双筋例1と同様の方法を用いて、切5図の断面 似道をもつインクジェットヘッドを製道した。

双路例1の製造プロセスにおいて、ダイヤフラム 節503に所定のパターンを持った包括504を形成した役。この関題上にSi0。 即を3000人形成してインクとの絶数化処理を行った。

このインクジェットヘッドは契施例 1 と同様の 方法により吐出口よりインク級を飛ばすことがで 後、通常のフォトリソエッチング工程をへて所定 のパターンを形成した。

5) 夏に直径50μmのインク吐出口106を持つ口さ50μmのノズルブレート 芸板105を芸板102との問題が800μmとなるようにスペーサー107と108を入れエポキシ樹脂を用いて貼り合わせた。

6) このようにして組み立てられたインクジェットへッドの両例に永久磁石110、120を昇1 図に示すように磁접を配配することにより本発明のインクジェットヘッドを作った。

7) 芸板102と105の間にインクを渦たした

### 8 t.

### [発明の効果]

以上変施例よりわかるように、本発明のインクジェットヘッドは、駆励に発照方式を取らないため呆子の脅命が長く、かつ駆励案子がICプロセスに代表される刃阻加工プロセスにより形成されるため駆励案子の高密度化が可能である。

即ち、本発明によれば西 50 命かつ 15 印字品質 ( 高密度ドット) のインクジェットヘッドが可能 となった。

## 4. 図面の簡単な説明

到 1 図 (a) は本発明のインクジェットヘッドの上面図、以 1 図 (b) は本発明のインクジェットヘッドの断面図。

知 2 図は本発明のインクジェットヘッドダイヤフラム 邸の断面形状図。

第3図は従来の発熱式インクジェットヘッドの 断面図。

算4回は従来の圧電景子式インクジェットへっ

# 特別平4-129745 (4)

ドの断面図。

第5図は本発明のインクジェットヘッドの断面 図。

- 100・・・インク吐出口(ノズル)
- 101・・・パイレックス基板
- 102···Si 基板
- 103・・・ダイヤフラム部
- 104・・・配線
- 105・・・ノズルブレート
- 106 · · · 液晶
- 107 . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 108・・・スペーサー
- 110 · · · 盘石
- 120 · · · 磁石
- 301・・・基板
- 302 · · · 発熱体
- 303・・・ノズルブレート
- 305・・・ノズル (インク吐出口)

401. · · 基板

403・・・ノズルブレート

405・・・ノズル(インク吐出口)

500・・・ノズル

501・・・パイレックスガラス基板

5 0 2 · · · S i 基板

503・・・ダイヤフラム部

504・・・配線

505・・・ノズルブレート

506...液晶

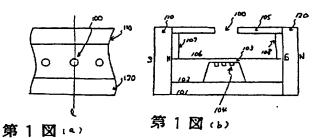
508・・・スペーサー

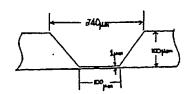
509···艳珠膜(SiO<sub>2</sub>)

5 1 0 · · · 磁石

5 2 0 · · · 班石

以上





第2图

